









	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> IPD50N04S309ATMA1</p>
	<p><b>Hersteller / Marke:</b> International Rectifier (Infineon Technologies)</p>
	<p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 40V 50A TO252-3</p>
	<p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">IPD50N04S309ATMA1.pdf</a></p>
<p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p>	<p><b>Lagerzustand:</b> New original, Stock Available.</p>
<p><b>Lieferung von:</b> Hong Kong</p>	<p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	IPD50N04S309ATMA1
Hersteller	International Rectifier (Infineon Technologies)
Beschreibung	MOSFET N-CH 40V 50A TO252-3
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 28µA
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PG-TO252-3
Serie	OptiMOS™
Rds On (Max) @ Id, Vgs	9 mOhm @ 50A, 10V
Verlustleistung (max)	63W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1750pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	26nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	40V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	50A (Tc)

IPD50N04S309ATMA1 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, IPD50N04S309ATMA1-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, IPD50N04S309ATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.  
RFQ IPD50N04S309ATMA1 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>IPD50N04S3L-08</b> I I TO-252</p>	 <p><b>IPD50N04S4-10</b> I IPD50N04S4-10 I</p>	 <p><b>IPD50N04S3-09</b> INFINEO IPD50N04S3-09 INFINEO</p>	 <p><b>IPD50N04S410ATMA1</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH 40V 50A TO252-3-313</p>
 <p><b>IPD50N04S4-08</b> INFINEO IPD50N04S4-08 INFINEO</p>	 <p><b>IPD50N04S3-8</b> INFINEON IPD50N04S3-8 INFINEON</p>	 <p><b>IPD50N04S3-08</b> Infineon Technologies IPD50N04S3-08 Infineon Technologies</p>	 <p><b>IPD50N04S408ATMA1</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH 40V 50A TO252-3-313</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

IPD50N04S309ATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies)	IPD50N04S309ATMA1 Datenblatt	IPD50N04S309ATMA1-Datenblätter	IPD50N04S309ATMA1 PDF	International Rectifier (Infineon Technologies) IPD50N04S309ATMA1
IPD50N04S309ATMA1 Electronic	IPD50N04S309ATMA1-Komponenten	IPD50N04S309ATMA1-Verteiler	IPD50N04S309ATMA1-Bild	IPD50N04S309ATMA1-Teil
IPD50N04S309ATMA1 Preis	IPD50N04S309ATMA1 Hersteller	IPD50N04S309ATMA1 Bild	IPD50N04S309ATMA1 Aktie	IPD50N04S309ATMA1 Inventar
IPD50N04S309ATMA1 Neu	IPD50N04S309ATMA1 Original	IPD50N04S309ATMA1 garantiert	IPD50N04S309ATMA1 RFQ	IPD50N04S309ATMA1 Online bestellen

Contact us: **Info@Y-IC.com**

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited